

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年3月31日 (31.03.2005)

PCT

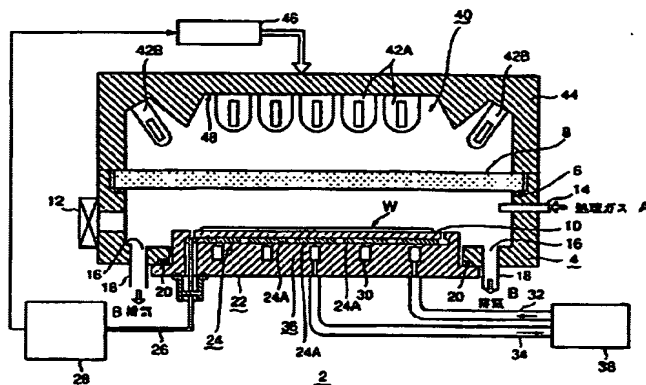
(10) 国際公開番号
WO 2005/029561 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 21/26 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/013922 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 清水 正裕
(22) 国際出願日: 2004年9月24日 (24.09.2004) (SHIMIZU, Masahiro) [JP/JP]; 〒4070192 山梨県韮
(25) 国際出願の言語: 日本語 崎市長坂町三ツ沢650番地 東京エレクトロ
(26) 国際公開の言語: 日本語 N A T株式会社内 Yamanashi (JP). 河西 繁 (KASAI,
(30) 優先権データ: 特願2003-332482 2003年9月24日 (24.09.2003) JP Shigeru) [JP/JP]; 〒4070192 山梨県韮崎市長坂町三
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京エツ 沢650番地 東京エレクトロN A T株式会社内 Ya
クトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) manashi (JP). 米田 昌剛 (YONEDA, Masatake) [JP/JP];
[JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 〒4070192 山梨県韮崎市長坂町三ツ沢650番地 東
Tokyo (JP). 京エレクトロN A T株式会社内 Yamanashi (JP).
- (74) 代理人: 吉武 賢次, 外(YOSHITAKE, Kenji et al); 〒
1000005 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士
ビル323号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: HEAT TREATMENT APPARATUS

(54) 発明の名称: 熱処理装置

A...TREATMENT GAS
B...EXHAUST

(57) **Abstract:** Disclosed is a heat treatment apparatus for conducting heat treatments such as annealing at a temperature not less than 400°C on an object such as a silicon wafer. The apparatus comprises a process chamber (4) which has a transmitting window (8) in a ceiling portion. A stage (10) on which an object to be treated (W) is placed is so arranged in the chamber as to face the transmitting window. Heating lamps (42A, 42B) are arranged above the process chamber for heating the object through the transmitting window by irradiating the object with heat rays. The stage (10) is provided with a thermoelectric converter (24) which is at least capable of cooling the object. Consequently, the object is mainly heated through irradiation of heat rays from the heating lamps, and forcedly cooled down using the thermoelectric converter.

(57) **要約:** シリコンウエハ等の被処理体に400°C以上の温度でアニール処理等の熱処理を施すための熱処理装置である。この装置は、天井部に透過窓(8)を有する処理容器(4)を備えている。この容器内は、透過窓と対向するように被処理体(W)を載置する載置台(10)が設けられている。処理容器の上方は、透過窓を通じて被処理体に熱線を照射することにより被処理体を加熱する複数の加熱ランプ(42A、42B)が設けられている。載

[続葉有]